



FIZIKA – MATEMATIKA FAKULTETI



F.I.SH: Abdikarimov Azamat Egamberganovich
LAVOZIM: katta o'qituvchi
TEJ: +998995909376
E – mail: abukarimov.azamat@rambler.ru;
azamat.abdikarimov@urdu.uz
TASHKILOT TEL: +99862 2246700
TASHKILOT MANZILI: Urganch shahar Xamid Olimjon ko'chasi 14. 220100

DARAJASI	• 2000 – 2004 Urganch Davlat Universiteti bakalavr (diplom) • 2004-2006 Urganch Davlat Universiteti Magistr (diplom) • 2021 F.-m.f. bo'yicha PhD. 01.04.10. Yarimotkazgichlar va dielektriklar fizikasi (O'zbekiston Milliy universiteti qoshidagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti)
TAJRIBA	• 2000-2004 yy. - Urganch davlat universiteti fizika-matematika fakulteti talabasi (bakalavr) • 2004-2006 yy. - Urganch davlat universiteti fizika-matematika fakulteti magistranti • 2006-2007 yy. – Urganch davlat universiteti qoshidagi 2-son Akademik litsey o'qituvchisi • 2007-2012 yy. - Urganch davlat universiteti fizika kafedrasida assistent o'qituvchisi • 2012-2014 yy. – Ispaniya davlati Santiago de Kompostella Universiteti talabasi • 2014-2016 yy. - Urganch davlat universiteti fizika kafedrasida katta o'qituvchisi • 2016-2019 yy. - Urganch davlat universiteti fizika kafedrasida tayanch (PhD) doktoranti • 2019-2021 yy. - Urganch davlat universiteti fizika kafedrasida katta o'qituvchisi • 2021 y. – h.v. - Urganch davlat universiteti fizika kafedrasida katta o'qituvchisi.
MUTAXASSISLIGI	• Fizika.
O'QITADIGAN FANLARI	• Termodinamika va statistik fizika asoslari, Nanofizika asoslari, Yarimo'tkazgich asboblarni modellashtirish, Fotovoltaika fizik asoslari.
TADQIQOT ISHI	• Nanolchamli yarimotkazgich asboblarni modellashtirish, Quyosh elementlarini modellashtirish
TADQIQOTLARI	• 2016-2019. RENES – “Development of the Master program in renewable energy and sustainable environment” (Erasmus+ program) Loyixasi. • 2017-2020. “Si-SiO₂ chegara va oksid katlamida nuksonlarni taksimotini aniqlashga yangicha yondashish”. Loyixa. Innovacion rivojlanish vazirligi. • 2021-2023. Xindiston –Ozbekiston koshma loyixasi “Self Heating Effect on stacked

	Nanosheet Field Effect Transistor”
HOZIRGI TADQIQOTLARI	1. Atamuratov A. E., Abdikarimov A., Khalilloev M., Atamuratova Z. A., Rahmanov R., Garcia-Loureiro A., Yusupov A. Simulation of DIBL effect in 25 nm SOI-FinFET with the different body shapes // -2017. Nanosystems: Physics. Chemistry. Mathematics. 8 (1). pp. 71–74. (01.00.00, №5) 2. Abdikarimov A., Atamuratov A.E., Khalilloev M., Atamuratova Z. A., Rahmanov R., Yusupov A. Simulation Study Of Subthreshold Slope in 25 nm SOI-FinFET With The Different Body Shape // 2017. ДАН. № 3. с. 20-23. (01.00.00, №7) 3. Abdikarimov A.E., Yusupov A., Atamuratov A.E. The effect of the fin shape and thickness of the buried oxide on the DIBL effect in an SOI FinFET // -2018. Technical Physics Letters. Vol.44. No.11. pp. 962-964. (Scopus IF= 0.791) 4. Абдикаримов А.Э., Юсупов А., Атамуратов А.Э., Влияние бокового расширения затвора на короткоканальные эффекты в нанометровом FinFET-транзисторе // - 2019. УФЖ. Vol. 21. №1. pp. 50-52. (01.00.00, №5) 5. Abdikarimov A.E., Yusupov A., Atamuratov A.E. Intercapacitance between two charges located in the different environments // - 2018. Actual problems of modern science, education and training in the region. IV. pp. 33-37. (01.00.00, №10) 6. Abdikarimov A., Atamuratova Z. A., Yusupov A. Simulation study of short channel effects in low power FinFETs with different body shape and geometries // - 2018. International journal of applied science-research and review. Volume 5, pp. 41. (01.00.00, №5) 7. Abdikarimov A.E. The Influence of a Single Charged Interface Trap on the Subthreshold Drain Current in FinFETs with Different Fin Shapes // - 2020. Technical Physics Letters.– Vol. 46. No.5. pp. 494-496. (Scopus IF= 0.791) 8. Abdikarimov A., Indalecio G., Comesana E., Seoane N., Kalna K., Garsia-Lourero A. J., Atamuratov A. E. Influence of device geometry on electrical characteristics of a 10.7 nm SOI-FinFET //– 2014. IEEE Xplore Digital Library. pp. 1-4. [Online] Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/-6865877 9. Abdikarimov A. E., Matyusupova N.B. Simulation of the effect of a single interface trapped charge in finfet with a gate length of 10 nm on the short channel effects // -2020. Electronic journal. VI. Actual problems of modern science, education and training. December-15. - pp.316-322. Issue1, ISSN Online: 2181-9750 [Online] Available: http://khorezmscience.uz/en/index/single/1 10. Abdikarimov A., Indalecio G., Comesana E., Seoane N., Kalna K., Garsia-Lourero A.J., Atamuratov A.E. Influence of device geometry on electrical characteristics of a 10.7 nm SOI FinFET // -2014. 17th International Workshop on Computational Electronics (IWCE 2014). Conference. Paris. France. June 3-6, pp. 247-248 11. Абдикаримов А., Ражабов О., Юсупов А. , Атамуратов А.Э. Влияние формы базы и толщины скрытого оксидного слоя на DIBL эффект в FinFET-транзисторе // - 2018. Республика илмий-техникавий анжуман, Мухаммад Ал-Хоразмий издошлари. Урганч. 27-28 апрель 9 -10 б. 12. Абдикаримов А.Э., Ражабов О., Юсупов А., Атамуратов А.Э. Влияние бокового линейного расширения затвора на пороговое напряжение и короткоканальные эффекты в FinFET-транзисторе с различной формой канала // -2018. IV Международной конференции по Оптическим и фотоэлектрическим явлениям в полупроводниковых микро-и наноструктурах. Фергана. 25-26 мая. с. 318-319. 13. Абдикаримов А.Э., Юсупов А., Атамуратов А.Э. Влияние формы базы и толщины скрытого оксидного слоя на крутизну передаточной характеристики FinFET-транзистора // - 2018. Материалы Республиканской конференции. Роль одаренной молодежи в развитии физики. Тошкент. 11-12 мая. с. 23-25. 14. Абдикаримов А.Э., Садуллаев С., Атамуратов А.Э. Влияние удлинения подзатворного оксидного слоя на крутизну передаточной характеристики и DIBL эффект FinFET-транзистора // - 2018. International conference.

Prospects for the intensive approach to innovative development. - Namangan. 10 - 11 july. pp. 222-223.

15. Абдикаримов А.Э., Юсупов А., Атамуратов А.Э. Влияние толщины скрытого оксидного слоя на DIBL эффект в кнi FinFET-транзисторе // - 2018. Республика илмий-амалий анжуман. Яримўтказгичлар физикасининг ва қайта тикланувчи энергия манбаларини ривожлантиришнинг замонавий муаммолари. Андижон, 20 - 21 апрель. 90 – 91 б.
16. Абдикаримов А.Э., Юсупов А., М. Халиллоев., Атамуратов А.Э. Влияние удлинения подзатворного оксидного слоя на передаточную подпороговую характеристику и DIBL эффект кнi FinFET-транзистора с различной формой базы // - 2018. Республика илмий-амалий анжумани материаллари. Яримўтказгичлар физикасининг ҳозирги замон муаммолари. -Тошкент. 26-27 октябрь. 84-86 б.
17. Абдикаримов А.Э., Юсупов А., Ражабов О., Ахмедова С., Атамуратов А.Э. Влияние удлинения подзатворного оксидного слоя на короткоканальные эффекты в кнi FinFET-транзисторе // -2018. Материалы республиканской научно-практической конференции. Инновационные технологии в науке и образовании. Нукус. 20-21 ноября. С. 121-124.
18. Абдикаримов А.Э., Садуллаев С., Нуруллаев Н., Атамуратов А.Э., Юсупов А. Распределение амплитуды сигнала случайного телеграфного шума вдоль канала FinFET транзистора с различной формой // – 2019. Республиканской конференции (с участием ученых стран СНГ). Современные проблемы физики полупроводников. Нукус. 20 ноября. С. 276-279.
19. Yusupov A., Atamuratov A., Abdikarimov A. The amplitude of RTN in nanometer SOI FinFET with different channel shape // - 2020. World Scientific Proceedings Series on Computer Engineering and Information Science 12. Developments of Artificial Intelligence Technologies in Computation and Robotics. Proceedings of the 14th International FLINS Conference . pp.1541-1548.
20. Абдикаримов А.Э., Атамуратов А.Э., Юсупов А. Канал узунлиги 10 нм бўлган вертикал майдоний транзисторнинг оксид-яримўтказгич қатлам чегара сиртидаги нуқсонда камралган яқка заряднинг DIBL эффектига таъсирини моделлаштириш // - 2020. Замонавий микроэлектрониканинг ривожланишида фан, таълим ва инновация интеграцияси. Андижон. 24 - 25 декабрь. 183–185 б.
21. Ўзбекистон республикаси интеллектуал мулк агентлигининг электрон ҳисоблаш машиналари учун яратилган дастурнинг расмий рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома олиш учун “Наноўлчамлардаги вертикал Майдон транзисторларда сток томонидан потенциал тўсиқнинг пасайтирилиш эффектини ҳисоблаш” учун ЭХМ дастур яратилди № DGU 20180753. Интеллектуал мулк агентлиги “Расмий ахборотнома” бюллетенида нашр қилинди.
22. Ўзбекистон республикаси интеллектуал мулк агентлигининг электрон ҳисоблаш машиналари учун яратилган дастурнинг расмий рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома олиш учун “Наноўлчамлардаги вертикал Майдон транзисторларда бўсагадан паст ўтиш вольт-ампер характеристикасининг қиялигини ҳисоблаш” учун ЭХМ дастур яратилди № DGU 20180754. Интеллектуал мулк агентлиги “Расмий ахборотнома” бюллетенида нашр қилинди.